

財團法人工業技術研究院 函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人：李怡秋

電話：03-5917759

傳真：03-5910466

E-mail：Lislee@itri.org.tw



1110010731010

106 台北市大安區復興南路一段 390 號 9 樓

受文者：台灣區車輛工業同業公會

發文日期：中華民國 111 年 05 月 31 日

發文字號：工研轉字第 1110010731 號

速別：普通件

密等：無

附件：如文

主旨：本院擬舉辦「111 年度工研院材料與化工研究所電子元件及基板相關研發成果非專屬授權案」之公開說明會，請轉知貴會會員等相關廠商把握機會參與本次推廣活動，請查照。

說明：

- 一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量，本院將舉辦電子元件及基板相關研發成果非專屬授權案(共計 59 案 118 件申請中、獲證專利)之公開說明會(授權標的詳如附件)。
- 二、「授權標的」共分為 7 個類別：(一)劣化偵測(7 案 17 件)、(二)連接器(7 案 17 件)、(三)發光二極體(9 案 23 件)、(四)電子元件(8 案 8 件)、(五)銅箔(14 案 3 4 件)、(六)離子交換膜(3 案 5 件)及(七)其他(11 案 14 件)。
- 三、有關本活動詳細資訊，請參考工研院研發成果公告網站(https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=01_content&SiteID=1&MmmID=1036461244216621372&MGID=1162612176534553065)。

111. 6. 01

車輛公會
收文總號

281

四、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

五、公開說明會：

(一) 舉辦時間：民國(下同)111年6月30日14時。

(二) 舉辦地點：採線上公開說明會。

(三) 報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於111年6月29日12時整(含)前以電子郵件向本案聯絡人報名(主旨請註明「111年度工研院材料與化工研究所電子元件及基板相關研發成果非專屬授權案：公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱)。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於111年6月29日17時整(含)前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

六、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 李小姐

電話：(03) 591-7759

傳真：(03) 582-0466

電子信箱：lislee@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣區車輛工業同業公會

院長 

依權責劃分規定授權業務主管決行

111 年度工研院材料與化工研究所

電子元件及基板相關研發成果非專屬授權案

- 一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）
- 二、非專屬授權標的：電子元件及基板相關研發成果，共計 59 案 118 件獲證及申請中專利。詳細資訊請參「附件：授權標的清單」。
- 三、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。
- 四、公開說明會：
 - （一）舉辦時間：民國（下同）111 年 6 月 30 日 14 時。
 - （二）舉辦地點：線上公開說明會。
 - （三）報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 111 年 6 月 29 日 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「111 年度工研院材料與化工研究所電子元件及基板相關研發成果非專屬授權案公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 111 年 6 月 29 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

五、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 李小姐

電話：03-5917759

傳真：03-5820466

電子信箱：lislee@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

附件：授權標的清單

專利分類	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	授權紀錄
劣化偵測	1	P54010 040CN	超聲波共振導波裝置	中國大陸	獲證	2012105551 02.0	CN103776906	2016 0413	2032 1218	工研院	
		P54010 040TW	超音波共振導波裝置	中華民國	獲證	101139057	I513095	2015 1211	2032 1022	工研院	
	2	P54020 088CN	管壁厚度測量模塊及應用其的管壁厚度測量方法	中國大陸	獲證	2014101288 48.2	CN104913715	2017 1208	2034 0331	工研院	
		P54020 088TW	管壁厚度量測模組及應用其之管壁厚度測量方法	中華民國	獲證	103108587	I500903	2015 0921	2034 0311	工研院	
	3	P54060 025CN	結構件的劣化偵測方法	中國大陸	獲證	2017114226 53.9	CN109254077	2021 0406	2037 1224	經濟部 技術處	
		P54060 025CN A1	應用結構單元的結構件的劣化偵測方法	中國大陸	獲證	2018104364 22.1	CN109765038	2021 0810	2038 0508	經濟部 技術處	
		P54060 025TW	結構件的劣化偵測方法	中華民國	獲證	106140912	I649543	2019 0201	2037 1123	經濟部 技術處	v
		P54060 025TW A1	應用結構單元的結構件之劣化偵測方法	中華民國	獲證	107107654	I715830	2021 0111	2038 0306	經濟部 技術處	
		P54060 025US	結構件的劣化偵測方法	美國	獲證	15/855,944	10481037	2019 1119	2038 0717	經濟部 技術處	
		P54060 025US A1	應用結構單元的結構件之劣化偵測方法	美國	獲證	16/111,033	10801914	2020 1013	2039 0214	經濟部 技術處	
	4	P54060 066TW	感測裝置	中華民國	獲證	106144731	I647436	2019 0111	2037 1219	經濟部 技術處	
	5	P54080 086CN	特定音源的定位方法	中國大陸	審查中	2020101462 87.4				經濟部 技術處	
		P54080 086TW	特定音源的定位方法	中華民國	獲證	108148521	I728632	2021 0521	2039 1230	經濟部 技術處	
	6	P54090 042TW	結構劣化的聲振診斷方法與系統	中華民國	審查中	110120800				經濟部 技術處	
		P54090 042US	結構劣化的聲振診斷方法與系統	美國	審查中	17/405,423				經濟部 技術處	
	7	P54090 067TW	結構體診斷系統及結構體診斷方法	中華民國	獲證	109146631	I742976	2021 1011	2040 1228	經濟部 技術處	

專利分類	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	授權紀錄
		P54090 067US	結構體診斷系統及 結構體診斷方法	美國	審查中	17/135,999				經濟部 技術處	
連接器	8	054900 010US D1	電子連接器之後端 電磁遮蔽元件	美國	獲證	10/601,569	6705897	2004 0316	2023 0623	經濟部 技術處	
	9	P05940 011CN	微型連接器及其端 子形狀的制法	中國大陸	獲證	2005100842 59.X	CN100495828	2009 0603	2025 0714	經濟部 技術處	
		P05940 011TW	微型連接器及其端 子形狀之製法	中華民國	獲證	94122260	I284628	2007 0801	2025 0630	經濟部 技術處	
		P05940 011US	微型連接器及其端 子形狀之製法	美國	獲證	11/478,658	7540751	2009 0602	2026 0702	經濟部 技術處	
		P05940 011US D1	微型連接器及其端 子形狀之製法	美國	獲證	11/806,917	7497712	2009 0303	2026 0702	經濟部 技術處	
		10	P54020 068CN	連接器	中國大陸	獲證	2014100545 68.1	CN104752904	2017 0301	2034 0217	經濟部 技術處
	P54020 068TW		連接器	中華民國	獲證	102149312	I563738	2016 1221	2033 1230	經濟部 技術處	
	11	P54020 069CN	連接器	中國大陸	獲證	2014100461 94.9	CN104752855	2017 0412	2034 0209	經濟部 技術處	
		P54020 069TW	連接器	中華民國	獲證	102148228	I548160	2016 0901	2033 1224	經濟部 技術處	
	12	P54960 035CN	微型連接器及其制 作方法	中國大陸	獲證	2007101529 00.8	CN101394036	2010 1215	2027 0920	經濟部 技術處	
		P54960 035CN A1	微型連接器及其制 作方法	中國大陸	獲證	2007101625 85.7	CN101414715	2011 0119	2027 1018	經濟部 技術處	
		P54960 035TW	微型連接器及其製 作方法	中華民國	獲證	96130332	I331831	2010 1011	2027 0815	經濟部 技術處	
		P54960 035TW A1	微型連接器及其製 作方法	中華民國	獲證	96135145	I331424	2010 1001	2027 0919	經濟部 技術處	
	13	P54980 078CN	細間距陣列型連接 器	中國大陸	獲證	2010100046 92.9	CN102130083	2012 0808	2030 0119	經濟部 技術處	
		P54980 078TW	細間距陣列型連接 器	中華民國	獲證	98145021	I411074	2013 1001	2029 1224	經濟部 技術處	
	14	P54990 075CN	連接器	中國大陸	獲證	2010106011 64.1	CN102487165	2014 0813	2030 1221	經濟部 技術處	
		P54990 075TW	連接器	中華民國	獲證	99142180	I396339	2013 0511	2030 1202	經濟部 技術處	

專利分類	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	授權紀錄
發光二極體	15	P05930082CN	一種鏡體及應用鏡體的均勻發光的發光二極管	中國大陸	獲證	200510002504.8	CN100388514	20080514	20250119	工研院	v
		P05930082TW	鏡體及應用鏡體之均勻發光之發光二極體	中華民國	獲證	93141245	I261654	20060911	20241228	工研院	v
		P05930082US	鏡體及應用鏡體之均勻發光之發光二極體	美國	獲證	11/196,254	7582913	20090901	20251222	工研院	v
	16	P54000106CN	照明裝置	中國大陸	獲證	201110432417.1	CN103133914	20150121	20311220	經濟部技術處	
		P54000106TW	照明裝置	中華民國	獲證	100143991	I434006	20140411	20311129	經濟部技術處	
		P54000106US	照明裝置	美國	獲證	13/439,872	8807794	20140819	20330307	經濟部技術處	
	17	P54950013CN	發光二極管的封裝結構	中國大陸	獲證	200610164256.1	CN100502068	20090617	20261206	工研院	v
		P54950013TW	發光二極體之封裝結構	中華民國	獲證	95136540	I311824	20090701	20261001	工研院	v
		P54950013US	發光二極體之封裝結構	美國	獲證	11/672,844	7528414	20090505	20270529	工研院	v
	18	P54950060CN	發光二極管的引線架	中國大陸	獲證	200610168388.1	CN100505345	20090624	20261226	工研院	v
		P54950060TW	發光二極體之引線架	中華民國	獲證	95146148	I342624	20110521	20261207	工研院	v
	19	P54950063CN	光源模塊	中國大陸	獲證	200710092118.1	CN101280891	20101006	20270401	工研院	v
		P54950063DE	光源模組	德國	獲證	10-2007022425.9	102007022425	20091224	20270509	工研院	v
		P54950063TW	光源模組	中華民國	獲證	96108882	I324669	20100511	20270314	工研院	v
		P54950063US	光源模組	美國	獲證	11/747,767	7427148	20080923	20270510	工研院	v
	20	P54950081CN	具有微鏡體結構的發光二極管芯片	中國大陸	獲證	200710003607.5	CN101226974	20110105	20270117	工研院	v
		P54950081TW	具有微鏡體結構之發光二極體晶片	中華民國	獲證	95150067	I371871	20120901	20261228	工研院	v
		P54950081US	具有微鏡體結構之發光二極體晶片	美國	獲證	11/826,469	8178892	20120515	20281216	工研院	v

專利分類	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	授權紀錄	
	21	P54950 127CN	電阻平衡電路	中國大陸	獲證	2007100883 85.1	CN101267697	2011 0706	2027 0315	工研院	v	
	22	P54960 012CN	光學薄膜及制造方法	中國大陸	獲證	2008100862 99.1	CN101545988	2012 0704	2028 0324	經濟部 技術處		
		P54960 012TW	光學薄膜及製造方法	中華民國	獲證	97108402	I383172	2013 0121	2028 0309	經濟部 技術處		
	23	P54960 073TW	光中介構件及光子卡模組	中華民國	獲證	96151030	I368768	2012 0721	2027 1227	經濟部 技術處		
		P54960 073US	光中介構件及光子卡模組	美國	獲證	12/110,358	7627215	2009 1201	2028 0520	經濟部 技術處		
	24	054900 012US	駐極體矽電容式麥克風之結構及其製法	美國	獲證	09/994,687	6870939	2005 0322	2022 0509	經濟部 技術處		
	25	P05930 001TW	壓電式揚聲器	中華民國	獲證	93108437	I241858	2005 1011	2024 0325	經濟部 工業局		
	26	P54030 061TW	用於鈍化處理之組成物、鈍化膜以及防蝕結構	中華民國	獲證	103145181	I518204	2016 0121	2034 1223	經濟部 技術處		
電子 元件	27	P54060 075TW	電透折裝置及其導流板	中華民國	獲證	107118797	I659775	2019 0521	2038 0530	經濟部 技術處	v	
	28	P54100 062TW	真空吸附爬牆機器人	中華民國	審查中	111103528				經濟部 技術處		
	29	P54950 123TW	氣喘監測設備與其軟性集音裝置和軟性集音器	中華民國	獲證	96109886	I319313	2010 0111	2027 0321	經濟部 技術處		
	30	P54970 087TW	紅外線輻射率的量測裝置及其方法	中華民國	獲證	97151507	I393868	2013 0421	2028 1229	經濟部 能源局		
	31	P54970 088TW	軟性集音裝置	中華民國	獲證	97142035	I410234	2013 1001	2028 1030	經濟部 技術處		
	銅箔	32	P05910 039CN	高高溫伸長率電解銅箔的制造方法	中國大陸	獲證	02156049.8	CN1314838	2007 0509	2022 1210	經濟部 技術處	
			P05910 039TW	高高溫伸長率電解銅箔之製造方法	中華民國	獲證	91125279	561201	2003 1111	2022 1024	經濟部 技術處	
33		P05910 045CN	具耐折性的電解銅箔的製造方法	中國大陸	獲證	02159066.4	CN1250775	2006 0412	2022 1226	經濟部 技術處		
		P05910 045TW	具耐折性之電解銅箔的製造方法	中華民國	獲證	91135058	583332	2004 0411	2022 1202	經濟部 技術處		
34		P54020 066TW	積層板及其製作方法	中華民國	獲證	102149311	I573687	2017 0311	2033 1230	經濟部 技術處		

專利分類	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	授權紀錄
	35	P54020 067TW	厚銅箔結構	中華民國	獲證	103121903	I527685	2016 0401	2034 0624	經濟部 技術處	
	36	P54040 047CN	複合積層板	中國大陸	獲證	2016106308 04.9	CN106626580	2019 1224	2036 0803	經濟部 技術處	
		P54040 047TW	複合積層板	中華民國	獲證	105119525	I617454	2018 0311	2036 0621	經濟部 技術處	
		P54040 047US	複合積層板	美國	獲證	15/256,084	10751975	2020 0825	2036 0901	經濟部 技術處	
	37	P54050 059CN	銅箔複材	中國大陸	獲證	2016112571 53.X	CN108267870	2021 0330	2036 1229	經濟部 技術處	
		P54050 059TW	銅箔複材	中華民國	獲證	105144023	I607866	2017 1211	2036 1229	經濟部 技術處	
	38	P54060 022CN	底漆組成物與使用 該底漆組成物的銅 箔基板	中國大陸	獲證	2018105524 37.4	CN109385174	2021 0427	2038 0530	經濟部 技術處	
		P54060 022TW	底漆組成物與使用 該底漆組成物之銅 箔基板	中華民國	獲證	107113094	I702264	2020 0821	2038 0416	經濟部 技術處	
		P54060 022US	底漆組成物與使用 該底漆組成物之銅 箔基板	美國	獲證	16/057,779	10917964	2021 0209	2039 0101	經濟部 技術處	
	39	P54060 023US D1	高頻電路用銅箔及 其製造方法	美國	審查中	16/917,914				經濟部 技術處	
	40	P54060 043CN	基板組合物及由其 所製備之基板	中國大陸	獲證	2018108250 43.1	CN109912908	2021 0518	2038 0724	經濟部 技術處	v
		P54060 043TW C1	基板組成物及由其 所製備之基板	中華民國	獲證	107121300	I695033	2020 0601	2038 0620	經濟部 技術處	v
		P54060 043US	基板組成物及由其 所製備之基板	美國	獲證	16/116,706	10640637	2020 0505	2038 0914	經濟部 技術處	v
	41	P54070 019CN	銅箔及其製造方法 與儲能裝置的集電 體	中國大陸	審查中	2019100967 46.X				經濟部 技術處	
		P54070 019CN C1	電解銅箔與儲能裝 置的集電體	中國大陸	獲證	2019108514 02.5	CN110894615	2021 0226	2039 0909	經濟部 技術處	
		P54070 019TW C1	電解銅箔與儲能裝 置的集電體	中華民國	獲證	108125545	I696727	2020 0621	2039 0718	經濟部 技術處	

專利分類	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	授權紀錄	
		P54070 019US C1	電解銅箔與儲能裝置的集電體	美國	獲證	16/578,413	10985378	2021 0420	2039 0305	經濟部 技術處		
	42	P54070 035CN	偵測系統及偵測方法	中國大陸	獲證	2019112563 97.X	CN111385724	2021 1228	2039 1209	經濟部 技術處		
		P54070 035TW	偵測系統及偵測方法	中華民國	獲證	107147579	I683104	2020 0121	2038 1227	經濟部 技術處		
		P54070 035US	偵測系統及偵測方法	美國	審查中	16/235,650				經濟部 技術處		
	43	P54080 080CN	底漆組合物及積層板	中國大陸	審查中	2020104932 14.2				經濟部 技術處		
		P54080 080TW	底漆組合物及積層板	中華民國	獲證	108148599	I731537	2021 0621	2039 1230	經濟部 技術處		
		P54080 080US	底漆組合物及積層板	美國	審查中	16/919,619				經濟部 技術處		
	44	P54090 023TW	電解銅箔與鋰電池負極集電體	中華民國	審查中	110100571				經濟部 技術處		
		P54090 023US	電解銅箔與鋰電池負極集電體	美國	審查中	17/407,127				經濟部 技術處		
	45	P54960 110CN	薄膜電阻結構及其製造方法	中國大陸	獲證	2008100993 11.2	CN101577159	2011 0413	2028 0508	經濟部 技術處		
		P54960 110JP	薄膜電阻結構及其製造方法	日本	獲證	2008-307478	4714260	2011 0401	2028 1201	經濟部 技術處		
		P54960 110TW	薄膜電阻結構及其製造方法	中華民國	獲證	97113003	I369693	2012 0801	2028 0409	經濟部 技術處		
		P54960 110US	薄膜電阻結構及其製造方法	美國	獲證	12/135,918	8004386	2011 0823	2030 0614	經濟部 技術處		
	離子交換膜	46	P05920 051TW	具不同分子滲透速率之質子交換膜	中華民國	獲證	93103839	I276654	2007 0321	2024 0217	經濟部 技術處	
			P05920 051US	具不同分子滲透速率之質子交換膜	美國	獲證	10/864,546	7527887	2009 0505	2026 1114	經濟部 技術處	
		47	P05930 074CN	質子傳導膜及其製法	中國大陸	獲證	2005100077 11.2	CN100412116	2008 0820	2025 0206	經濟部 技術處	
P05930 074TW			質子傳導膜及其製法	中華民國	獲證	94103353	I281283	2007 0511	2025 0202	經濟部 技術處		
48		P05940 035TW	一種用於改善基材疏水性之高分子化合物以及包含該化合物之塗料組成物	中華民國	獲證	94146929	I308159	2009 0401	2025 1227	經濟部 技術處		

專利分類	案編號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	授權紀錄
其他	49	054910 020CN	具有自然通風效果的居室	中國大陸	獲證	02132238.4	CN1480611	2005 0316	2022 0902	經濟部 能源局	
	50	P05920 026TW	在輕金屬合金表面形成黑色不反射鍍層的方法	中華民國	獲證	92128943	I242609	2005 1101	2023 1016	經濟部 技術處	
	51	P05920 027TW	熱浸鍍鋅鋼微電弧電漿氧化表面處理法	中華民國	獲證	92128942	I224633	2004 1201	2023 1016	經濟部 技術處	
	52	P05930 004TW	製造金屬奈米粒子之方法	中華民國	獲證	93113911	I282778	2007 0621	2024 0517	經濟部 技術處	
	53	P05930 031TW	觸控面板坐標定位系統	中華民國	獲證	93135923	I253584	2006 0421	2024 1122	經濟部 技術處	
	54	P05930 042TW	節能裝置	中華民國	獲證	93140983	I243872	2005 1121	2024 1227	經濟部 能源局	
	55	P05930 048TW	透光隔熱元件	中華民國	獲證	93140576	I264453	2006 1021	2024 1223	經濟部 能源局	v
	56	P05930 072CN	基材表面的疏水結構及其制法	中國大陸	獲證	2005100511 41.7	CN100540153	2009 0916	2025 0227	經濟部 技術處	
		P05930 072TW C1	基材表面之疏水結構及其製法	中華民國	獲證	94103550	I261615	2006 0911	2025 0203	經濟部 技術處	v
	57	P05930 073TW C1	一種形成於基材上之超疏水性表面結構及其製法	中華民國	獲證	94103547	I291902	2008 0101	2025 0203	經濟部 技術處	
	58	P54000 125TW	呼吸監測器	中華民國	獲證	101207565	M435915	2012 0821	2022 0423	經濟部 技術處	
		P54000 125US	呼吸監測器	美國	獲證	29/419,049	D701315	2014 0318	2028 0317	經濟部 技術處	
	59	P54010 102CN	熔鹽組合物	中國大陸	獲證	2012105666 47.1	CN103849358	2016 1228	2032 1223	經濟部 技術處	
P54010 102TW		熔鹽組合物	中華民國	獲證	101144439	I473764	2015 0221	2032 1127	經濟部 技術處		